



Transistor RF de Potencia NPN / 30 MHz / 13.6 Vcc / 4.0 A / 10 W / TO-220AB

SKU: MRF475 Categoría: KENWOOD / ICOM / TXPRO

\$599.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transistor NPN de potencia RF fabricado en silicio, diseñado para aplicaciones de amplificación en alta frecuencia hasta 30 MHz. Ofrece una potencia de salida de 10 W con alta eficiencia energética del 40%, ideal para equipos de comunicación y transmisores en banda HF. Su encapsulado TO-220AB con configuración emisor común facilita la integración en diseños de RF. Soporta corrientes de colector hasta 4.0 A con excelente disipación térmica gracias a su resistencia térmica unión-carcasa de 12.5°C/W.

Transistor NPN de potencia RF en silicio

Frecuencia operativa hasta 30 MHz

Tensión colector-emisor: 13.6 Vcc nominal

Corriente máxima de colector: 4.0 A

Potencia de salida: 10 W

Paquete TO-220AB con configuración emisor común

Máximos Ratings Absolutos

width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 13px;	
Corriente de colector (I _C)	4.0 A
Tensión colector-emisor (V _{CE})	18 V
Tensión colector-base (V _{CB})	48 V
Disipación de potencia (P _D)	10 W
Temperatura de almacenamiento (T _{STG})	-65°C a +150°C
Temperatura de unión (T _J)	-65°C a +150°C

Características Térmicas

width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 13px;	
Resistencia térmica unión-carcasa (θ _{J-C})	12.5°C/W
BV _{CEO}	20 mA
BV _{CES}	50 mA
BV _{EBO}	5.0 mA
I _{CB0}	25 V
C _Q	300 mA
h _{FE}	5.0 V, I _C = 500 mA
Ganancia de potencia (G _P)	10-12 dB
Eficiencia (η)	40%
Distorsión de intermodulación (IMD)	30 dB

Configuración Física

width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 13px;	
Paquete	TO-220AB (Common Emitter)
Pin 1	Base
Pin 2	Colector
Pin 3	Emisor
Tab (aleta de disipación)	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación hasta 30 MHz para amplificación RF
Característica 2	Potencia de salida de 10 W con alta eficiencia del 40%
Característica 3	Ganancia de potencia de 10-12 dB en banda HF
Característica 4	Paquete TO-220AB con disipación térmica optimizada
Característica 5	Rango de temperatura operativa -65°C a +150°C
Característica 6	Configuración emisor común para diseño simplificado